

高速ピコ秒光パルス発生と計測

Generation and Measurement of High Speed Optical Pulses

鈴木克弘

Yoshihiro SUZUKI

電子技術総合研究所

Electro-technical Laboratory

佐藤卓哉

Takuya SATO

1 はじめに

近年半導体レーザを用いた超短光パルス列の発生に関する研究が多くの関心を集めています。最近ではサブピコ秒の光パルスを得られるに至ってます。⁽¹⁾⁽²⁾ この超短光パルスは高距離分解能をもえ、さらに半導体レーザの実用上の利点とともにあわせると、半導体レーザのレーザレーダへの応用も興味あるものと思われる。我々は、レーザレーダへの直接的応用をめざしてはいるが、基礎技術として、半導体レーザからの高速光パルス列の発生について研究を進めています。最近、マイクロ波電流直接変調と外部共振器を用いて半導体レーザ発振器で繰り返し周波数 7GHz 、パルス幅約 30ps の高速光パルス列を得たので、その概要について述べる。

2 実験装置

Fig. 1 に実験装置の構成を示す。使用した半導体レーザ素子は TJS 型の GaAlAs LD (ML-2307型) で、片面に無反射コートを施している。無反射コートにより LD のしきい値電流は 24mA から 30mA に増大した。発振波長は約 890nm である。外部共振器は、NA. 0.25 の VLP レンズとアルゴコートのフラットミラーで構成している。共振器長は約 2cm で、モード間隔を約 7GHz に設定した。外部共振器と構成することによりしきい値電流は約 27.6mA に低下した。変調用の 7GHz マイクロ波信号は DC 電流に重畠して LD に加えている。マイクロ波信号発生器には、スイープオシレータを用い、その周波数安定度は $500\text{kHz}/\text{°C}$ 程度であり、出力は約 40mW である。

出射レーザ光についての測定は、Fig. 1 に示すように、分光器と Si-ビジコンにより素子モード(間隔約 4.5A)スペクトラムの観測を、次に掃引型アブリペロ-干渉計 (FSR 約 60GHz) により外部共振器モード(約 7GHz 間隔)スペクトラムの観測を行なう。最後に LiIO₃結晶(厚さ約 3mm)を用いて SHG 相関器により光パルス幅の測定を行なう。

3 実験結果

Fig. 2 に DC バイアス電流 28.3mA 、変調周波数 7.09GHz の時の良好な光パルスの SHG 相関波形を示す。横軸は遅延時間、縦軸は規格化された 2 連倍光の強度である。本図で左側のパルス波形は光パルスの自己相関波形で、右側のパルス波形は隣りの光パルス間の相互相関波形を示している。本図で、左右のパルス波形が良く一致していること、さらにはバックグラウンドの光強度ヒークの光強度比が $1:3$ であることから、均一な光パルス列が得られておりとお推定される。さらに、素子モードが 1 本であり、サブ構造をほとんど持たない良質な光パルスであると言える。次にパルス幅を推定するために本パルス波形を調べたところ、ガウス型に近いことが分かり、元の光パルスの半値全幅は、 $\Delta t = 29\text{ps}$ と推定された。

Fig. 3 に本光パルスが得られた時の外部共振器モードスペクトラムを示す。スペクトラムの包絡線もほぼガウス型に一致し、その半値全幅は、 $\Delta f = 17.2\text{GHz}$ であった。ここで $\Delta \omega$ と Δf の積をとると $\Delta \omega \cdot \Delta f = 0.50$ となり、ガウス型パルスの Transform-limit 値 0.44 にかなり近く本実験で得られた光パルスは良好なモードロックにより発生したものと推定される。

次に DC 電流モニタとて光パルス幅と変調周波数の関係を調べた結果を Fig. 4 に示す。本図で、プロットしておるのは、素子モード数が複数となり、SHG 相関波形にサブ構造が発生し、非ヒーリングな光パルスが得られないから。本図から言える特徴的なことは他のレーザに比較して同調領域が広いこと。(2) DC バイアス電流が大きくなると同調範囲が狭くなること。(3) DC バイアスがスレッシュによって近傍でパルス幅は最も短くなること。(4) DC バイアス電流が変化すると同調周波数も変化し、電流が増大するに同調周波数は減少する。

最後に、左記、5に $\Delta\tau \cdot \Delta f$ 値を記す。本図から、DCバイアス入電流が 3mA の場合を除き、同調部では $\Delta\tau \cdot \Delta f$ 値は transform-limit 値に近く、良好なモードロック状態が得られておりといえよう。また、最大値は必ずしもパルス幅が最大の場合ではないことと言えよう。

4 おわりに

本実験では、特にエクタロンを用ひなくとも素子モードを一本にしほり、かつ、transform-limit に近く良好な、かつ高速な光パルス列を得ることができる。また、同調領域が広くとなり、実用的に使いやすくなるなどといふと言えよう。

最後に、日頃御指導をうけた東北大学稻場教授、伊藤助教授に感謝いたします。

参考文献

(1) 横山、伊藤、稻場、昭和56年秋季

応用物理学会連合講演会予稿集 8P-K-11,

(2) J.P. van den Ziel, R.A. Logan and R.M. Mikulyak, (DC; 28.3mA, RF; 7.09GHz)

Appl. Phys. Lett. 39(11) 867 (1981)

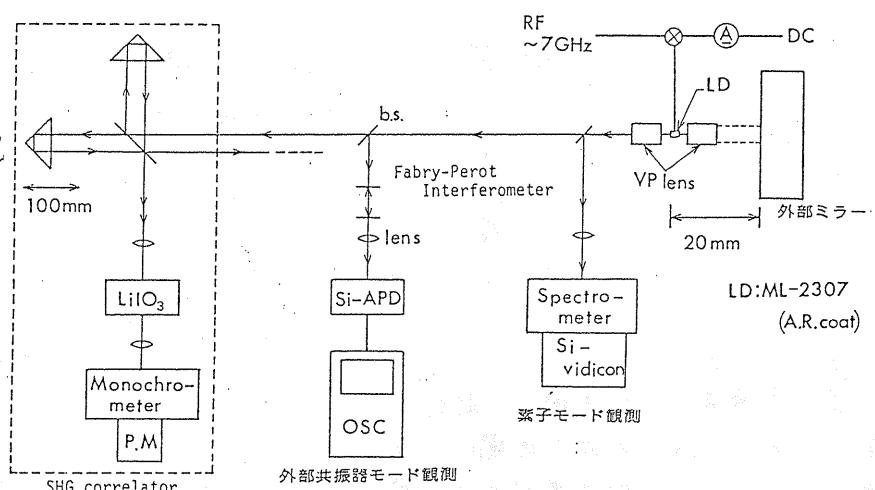


Fig. 1 半導体レーザモードロック実験装置

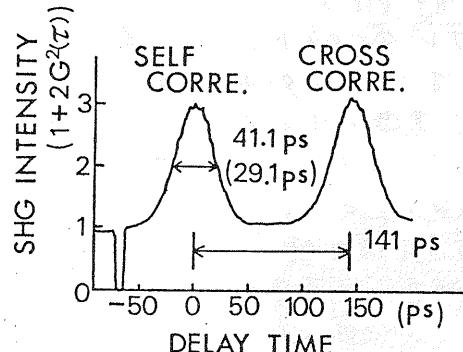


Fig. 2. SHG相關波形例

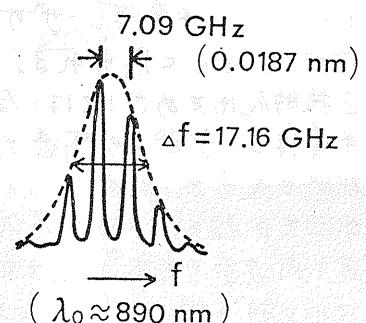


Fig. 3. 外部共振器モードスペクトラム

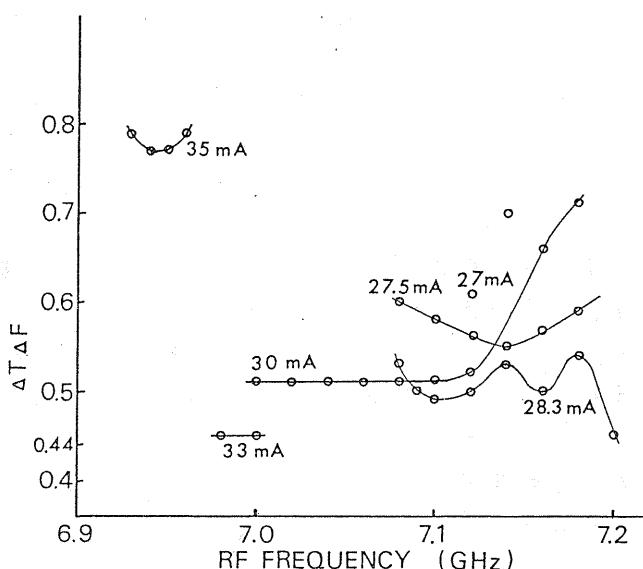


Fig. 5. Fig. 4 の実験結果につれて
 $\Delta\tau \cdot \Delta f$ 値とまとめた結果。

(0.44 はガウス型の transform-limit 値)

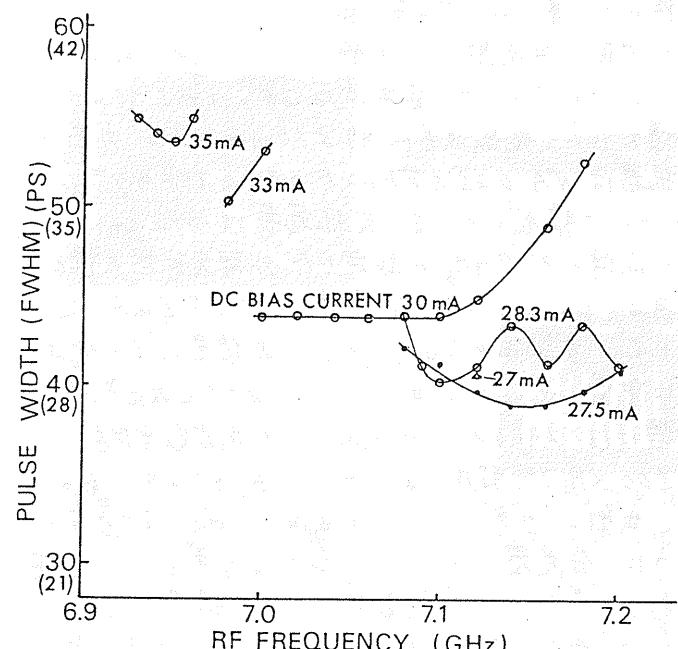


Fig. 4. 光パルス幅と DC バイアス電流及び
同調周波数の関係についての実験
結果。